

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2005 Thomson Derwent. All rts. reserv.

010554929 **Image available**

WPI Acc No: 1996-051882/199606

XRAM Acc No: C96-017019

Plasma etching of silicon@ substrate giving trenches with sidewall passivation - comprises masking substrate, etching trench by alternate or simultaneous use of etching and passivating gases and under-etching from trench floor using etching gas alone

Patent Assignee: BOSCH GMBH ROBERT (BOSC)

Inventor: BENZ G; LAERMER F; MUENZEL H; SCHILP A

Number of Countries: 002 Number of Patents: 004

Patent Family:

| Patent No | Kind | Date | Applicat No | Kind | Date | Week |
|------------|------|----------|-------------|------|----------|----------|
| GB 2290413 | A | 19951220 | GB 9511873 | A | 19950612 | 199606 B |
| DE 4420962 | A1 | 19951221 | DE 4420962 | A | 19940616 | 199606 |
| GB 2290413 | B | 19980415 | GB 9511873 | A | 19950612 | 199817 |
| DE 4420962 | C2 | 19980917 | DE 4420962 | A | 19940616 | 199841 |

Priority Applications (No Type Date): DE 4420962 A 19940616

Patent Details:

| Patent No | Kind | Lan | Pg | Main IPC | Filing Notes |
|-----------|------|-----|----|----------|--------------|
|-----------|------|-----|----|----------|--------------|

| | | | | | |
|------------|---|----|--|--------------|--|
| GB 2290413 | A | 10 | | H01L-021/306 | |
|------------|---|----|--|--------------|--|

| | | | | | |
|------------|----|---|--|--------------|--|
| DE 4420962 | A1 | 4 | | H01L-021/308 | |
|------------|----|---|--|--------------|--|

| | | | | | |
|------------|---|--|--|--------------|--|
| GB 2290413 | B | | | H01L-021/306 | |
|------------|---|--|--|--------------|--|

| | | | | | |
|------------|----|--|--|--------------|--|
| DE 4420962 | C2 | | | H01L-021/308 | |
|------------|----|--|--|--------------|--|

Abstract (Basic): GB 2290413 A

Method of processing a Si substrate by: (a) masking the substrate; (b) etching a trench by exposure to plasma, in which an etching gas and a passivating gas are used together or alternately to give sidewall passivation; (c) an under-etching proceeding from the trench floor is introduced in the etching process by the etching gas alone.

USE - Processing of Si substrates.

ADVANTAGE - Sidewall passivation and isotropic etching can be done in the same etching system.

Dwg.3/4

Abstract (Equivalent): GB 2290413 B

Method of processing a Si substrate by: (a) masking the substrate; (b) etching a trench by exposure to plasma, in which an etching gas and a passivating gas are used together or alternately to give sidewall passivation; (c) an under-etching proceeding from the trench floor is introduced in the etching process by the etching gas alone.

USE - Processing of Si substrates.

ADVANTAGE - Sidewall passivation and isotropic etching can be done in the same etching system.

Dwg.1

Title Terms: PLASMA; ETCH; SILICON; SUBSTRATE; TRENCH; SIDEWALL; PASSIVATION; COMPRISE; MASK; SUBSTRATE; ETCH; TRENCH; ALTERNATE; SIMULTANEOUS; ETCH; PASSIVATION; GAS; ETCH; TRENCH; FLOOR; ETCH; GAS

Derwent Class: L03; U11

International Patent Class (Main): H01L-021/306; H01L-021/308

International Patent Class (Additional): C23F-004/00; H01L-021/3065

File Segment: CPI; EPI

Manual Codes (CPI/A-N): L04-C07D; L04-C07E

Manual Codes (EPI/S-X): U11-C07A1; U11-C07C1
Derwent Registry Numbers: 0367-U; 0975-U
?



①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

● **Offenlegungsschrift** ●
⑩ **DE 44 20 962 A 1**

⑤1 Int. Cl.⁸:
H 01 L 21/308
C 23 F 4/00

②1 Aktenzeichen: P 44 20 962.2
②2 Anmeldetag: 16. 6. 94
④3 Offenlegungstag: 21. 12. 95

DE 44 20 962 A 1

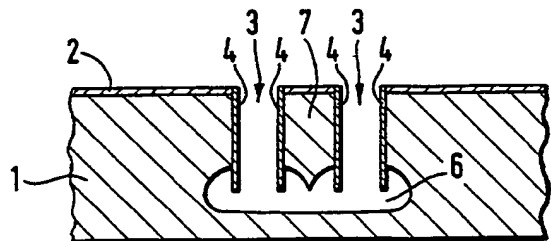
⑦1 Anmelder:
Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE

⑦2 Erfinder:
Benz, Gerhard, Dr., 71032 Böblingen, DE; Muenzel,
Horst, Dipl.-Phys. Dr., 72770 Reutlingen, DE;
Laermer, Franz, Dr., 70437 Stuttgart, DE; Schilp,
Andrea, 73525 Schwäbisch Gmünd, DE

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤4 Verfahren zur Bearbeitung von Silizium

⑤7 Es wird ein Verfahren zur Bearbeitung von Siliziumsub-
straten (1) vorgesehen, bei dem das Siliziumsubstrat in eine
Plasmaätzanlage eingebracht wird. Durch einen ersten Ätz-
schritt wird ein Graben (3) mit einer Seitenwandpassivierung
(4) erzeugt. Durch eine isotrope Plasmaätzung wird dann die
Unterätzung (6) erzeugt.



DE 44 20 962 A 1

Stand der Technik

Die Erfindung geht aus von einem Verfahren zur Bearbeitung von Silizium nach der Gattung des unabhängigen Anspruchs 1. Aus der US-4 784 720 ist bereits ein Verfahren zur Bearbeitung von Silizium in einer Plasmaätzanlage bekannt, bei dem ein Ätzgas und ein Passiviergas verwendet werden. Durch Anwendung des Ätzgases und des Passiviergases wird ein Graben mit einer Seitenwandpassivierung geschaffen. Als Ätzgas wird ein Chlor- oder Bromlieferant verwendet. Da Chlor und Brom nur bei höheren Ionenenergien im Plasma eine nennenswerte Ätzung von Silizium bewirken, lassen sich mit diesen Ätzgasen nur stark anisotrope Ätzprofile realisieren. Aus der DE 39 27 163 A1 ist ein Verfahren zur Bearbeitung von Silizium bekannt, bei dem ein Ätzgraben mit einer Seitenwandpassivierung erzeugt wird. Durch isotropes Plasmaätzen kann dann ausgehend von den Bodenbereichen der Gräben eine Unterätzung von Strukturen erfolgen. Da als Seitenwandpassivierung ein Niedertemperaturoxid oder -nitrid vorgesehen ist, erfordert das Verfahren mehrere Bearbeitungsschritte in unterschiedlichen Ätzanlagen und Abscheideanlagen (Plasmaätzter, PECVD- oder LPCVD-Anlage).

Vorteile der Erfindung

Das erfindungsgemäße Verfahren mit den kennzeichnenden Merkmalen des unabhängigen Anspruchs 1 hat demgegenüber den Vorteil, daß in ein und derselben Ätzanlage sowohl ein Graben mit einer Seitenwandpassivierung erzeugt wird, wie auch eine isotrope Unterätzung der so gebildeten Strukturen erfolgen kann, ohne den Wafer zwischendurch aus der Anlage nehmen zu müssen. Es wird so ein besonders einfaches Verfahren angegeben, mit dem unterätzte Siliziumstrukturen erzeugt werden können.

Durch die in den abhängigen Ansprüchen aufgeführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen des im unabhängigen Anspruch angegebenen Verfahrens möglich. Durch die Verstärkung der Seitenwandpassivierung wird die seitliche Ätzbeständigkeit der Siliziumstrukturen bei der nachfolgenden isotropen Unterätzung verbessert. Durch ein Fluorplasma läßt sich Silizium besonders einfach und mit hohen Ätzraten bearbeiten. Durch fluorkohlenstoff- oder fluorkohlenwasserstoffhaltige Prozeßgase wird eine Seitenwandpassivierung aus einem chemisch besonders beständigen Fluorpolymer gebildet. Durch eine geringe Ionenenergie können einfache und dünne Ätzmaskierungen verwendet werden und trotzdem große Unterschiede in der Ätzrate von Siliziumsubstrat und Maskierungsstoff erzielt werden. Die gilt insbesondere bei hohen Plasmadichten und geringer Ionenenergie. Durch den alternierenden oder gleichzeitigen Einsatz von Ätz- und Passiviergas können tiefe und schmale Grabenstrukturen mit einer Seitenwandpassivierung gebildet werden.

Zeichnungen

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Figuren dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen die Fig. 1 ein Siliziumsubstrat mit einer Ätzmaskierung, Fig. 2 darin eingebrachte Ät-

gräben mit Seitenwandpassivierung, Fig. 3 die Unterätzung ausgehend vom Bodenbereich der Gräben und Fig. 4 eine Plasmaätzanlage.

Beschreibung der Erfindung

In der Fig. 1 ist ein Siliziumsubstrat 1 mit einer aufgetragenen Ätzmaskierung 2 gezeigt. Die Ätzmaskierung 2 bedeckt in vorgegebenen Bereichen die Oberfläche des Siliziumsubstrats nicht. In diesen Bereichen erfolgt in den weiteren Prozeßschritten ein Ätzangriff auf das Silizium. Als Materialien für die Ätzmaskierung 2 eignet sich beispielsweise eine dünne Schicht aus Fotolack oder Siliziumoxid. Das Siliziumsubstrat 1 wird zur weiteren Bearbeitung in eine Plasmaätzanlage eingebracht.

In der Fig. 2 wird das Siliziumsubstrat 1 nach einem ersten Plasmaätzschritt gezeigt. In den Bereichen, die von der Ätzmaske 2 nicht bedeckt waren, sind Gräben 3 eingeätzt. Die Gräben 3 weisen dabei ein Seitenwandpassivierung 4 auf. Im Bereich des Bodens 5 sind die Gräben 3 nicht mit einer Passivierschicht 4 bedeckt, so daß dort das Silizium des Substrats 1 freiliegt. Das Einätzen der Gräben 3 erfolgt durch Anwendung eines Gases, welches Silizium isotrop ätzt und eines Gases, welches eine Passivierschicht bildet. Als isotrop ätzendes Gas wird ein Gas, welches Fluor liefert, beispielsweise SF_6 oder NF_3 verwendet. Als Passiviergas wird ein Teflon bildendes Monomer, in der Regel ein Fluorkohlenstoff oder Fluorkohlenwasserstoff (CHF_3 , C_2F_6 , C_2F_4 , C_4F_8) verwendet. Das Ätz- und Passiviergas kann gleichzeitig in der Plasmaätzanlage in einer geeigneten Mischung verwendet werden. Alternativ ist es möglich, alternierend eine Vielzahl von aufeinanderfolgenden Ätz- und Passivierschritten vorzunehmen. Im Plasma können so bereits bei geringen Ionenenergien (wenige Elektronen Volt) unter der Voraussetzung einer hohen Plasmadichte perfekt anisotrop geätzte Gräben 3 von großer Tiefe (einige $10\text{ }\mu\text{m}$) und geringer Breite (wenige μm) erzielt werden. Aufgrund der geringen Ionenenergie ist der Abtrag der Ätzmaske 2 gering. Der Boden 5 der Gräben 3 bleibt infolge der Ioneneinwirkung frei und wird nicht mit dem teflonartigen Fluorpolymerfilm der Seitenwandpassivierung 4 bedeckt. Weiterhin ist es auch möglich, zusätzliche Gase wie Stickstoff, Sauerstoff oder Argon beizumischen, um die Prozesseigenschaften des Ätzprozesses zu beeinflussen. Um trotz der geringen Ionenenergie eine ausreichende Plasmadichte, d. h. eine ausreichend hohe Konzentration chemisch reaktiver Ionen zu gewährleisten, sollte die Plasmaätzanlage über eine geeignete Quelle verfügen und beispielsweise eine Mikrowellen- oder Magnetronplasmaanregung aufweisen.

Nachdem die gewünschte Ätztiefe der Gräben 3 erreicht ist, kann das Fluor liefernde eigentliche Ätzgas abgestellt werden und nur noch das Teflon bildende Passiviergas zugeführt werden. Durch diesen Prozeß kann die Dicke der Seitenwandpassivierung 4 erhöht werden. Dabei wird durch gleichzeitige Ioneneinwirkung dafür gesorgt, daß sich der Passivierfilm selektiv nur auf den Seitenwänden der Gräben 3 bildet und nicht auf dem Ätzgrund 5.

In der Fig. 3 werden die Gräben 3 nach einem weiteren Ätzschritt gezeigt. In diesem weiteren Ätzschritt wird das Siliziumsubstrat 1 ausschließlich mit dem Fluor liefernden Ätzgas bearbeitet. Die Energie des Plasmas wird dabei in der Größenordnung von nur wenigen Elektronenvolt gewählt, so daß die Ätzung nahezu perfekt isotrop erfolgt. Ausgehend von den freiliegenden

Ätzgrund 5 der Gräben 3 bildet dann die Unterätzung 6, wie sie in der Fig. 3 gezeigt wird. Die Ionenenergie wird dabei nicht exakt gleich null Elektronenvolt gesetzt, um zufällige mikroskopische Ablagerungen auf den Böden 5 während des isotropen Unterätzens noch entfernen zu können. Aufgrund der geringen Ionenenergie verursachen zufällig auf die Seitenwand treffende Ionen kaum einen Angriff an der Seitenwandpassivierung 4 oder an der Ätzmaske 2. Wenn, wie in der Fig. 3 gezeigt wird, zwei Gräben 3 in unmittelbarer Nachbarschaft angeordnet sind, so kann durch die isotrope Unterätzung 6 ein Siliziumsteg 7, der zwischen den beiden Gräben 3 angeordnet ist, komplett vom Substrat 1 gelöst werden. Mit derartigen Strukturen lassen sich beispielsweise dünne Biegeungen oder Kammstrukturen realisieren, die als Beschleunigungssensoren genutzt werden können.

An dem in den Fig. 1 bis 3 gezeigten Prozeßablauf ist besonders vorteilhaft, daß alle Ätzprozesse in ein und derselben Plasmaanlage in einem Prozeß ohne Unterbrechung oder Ausschleusen des Wafers erfolgen können. Die angesprochenen Ätz- und Passiviergase können miteinander oder nacheinander in ein und derselben Ätzanlage angewendet werden. Weiterhin erlauben sie die Ausbildung von besonders schmalen und tiefen Gräben 3, die in einem weiteren Prozeßschritt unterätzt werden können. Es können so Strukturen erzeugt werden, die als Sensoren verwendbar sind.

In der Fig. 4 wird schematisch eine Plasmaätzanlage 11 gezeigt. In der Plasmaätzanlage 11 ist das Siliziumsubstrat 1 und ein weiteres Mittel 10 zur Plasmaerzeugung eingebracht. An das Substrat 1 kann eine hochfrequente Spannung angelegt werden, die die Energie, mit der Ionen auf das Substrat 1 auftreffen, bestimmt. Die weiteren Mittel zur Plasmaerzeugung 10 können als einfache Elektrode, Mikrowellengenerator, Magnetron oder jede andere Plasmaquelle die eine hohe Plasmadichte erzeugt ausgebildet sein.

weise geringer als 1 Elektronenvolt, gewählt wird. 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zum Einbringen des Grabens (3) das Siliziumsubstrat (1) abwechselnd mit dem Ätz- und dem Passiviergas bearbeitet wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß zum Einbringen des Grabens (3) das Siliziumsubstrat (1) gleichzeitig mit einer Mischung des Ätz- und des Passiviergases bearbeitet wird.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

Patentansprüche

1. Verfahren zur Bearbeitung von Silizium, bei dem ein Siliziumsubstrat (1) mit einer Ätzmaskierung (2) versehen wird und in eine Plasmaätzanlage eingebracht und mit einem Plasma beaufschlagt wird, wobei durch Bearbeitung mit einem Ätzgas und einem Passiviergas ein Graben (3) mit einer Seitenwandpassivierung (4) erzeugt wird, dadurch gekennzeichnet, daß in einem weiteren Bearbeitungsschritt in der Ätzanlage durch das Ätzgas, ausgehend vom Ätzgrund (5) des Grabens (3), eine Unterätzung (6) eingebracht wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß vor dem Einätzen der Unterätzung (6) durch einen Abscheideschritt die Seitenwandpassivierung (4) verstärkt wird.
3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß für das Ätzgas ein Fluor lieferndes Gas (z.Bsp. SF_6 oder NF_3) ausgewählt wird.
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als Passiviergas ein Fluorkohlenstoff oder Fluorkohlenwasserstoff (z. Bsp. CHF_3 , C_2F_6 , C_2F_4 , C_4F_8) lieferndes Gas ausgewählt wird.
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Plasmaenergie geringer als 50 Elektronenvolt, vorzugs-

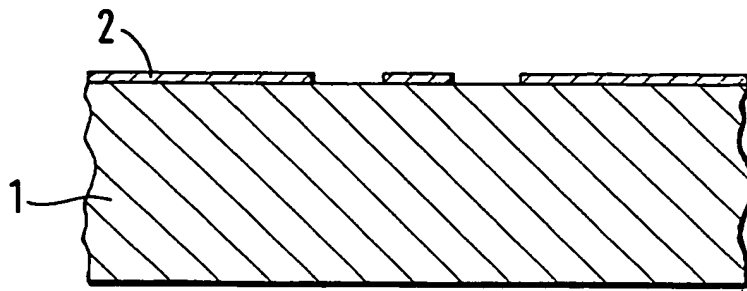


FIG. 1

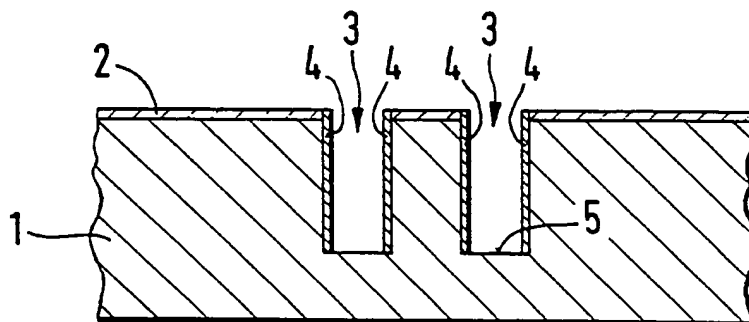


FIG. 2

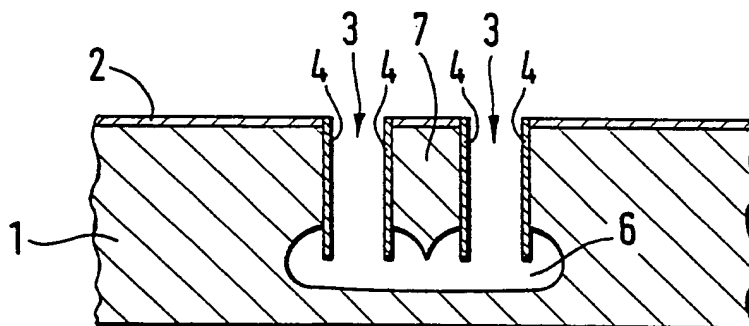


FIG. 3

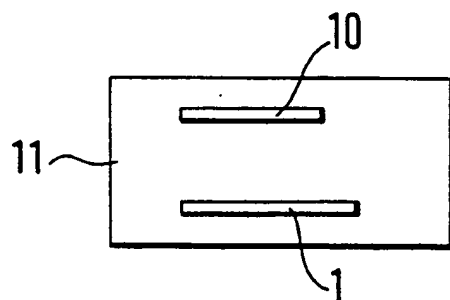


FIG. 4